

Title (en)

MEMORY CELL HAVING MORE THAN TWO VOLTAGE LEVELS.

Title (de)

SPEICHERZELLE MIT MEHR ALS ZWEI SPANNUNGSEBENEN.

Title (fr)

CELLULE DE MEMOIRE AYANT PLUS DE DEUX NIVEAUX DE TENSION.

Publication

EP 0072846 A1 19830302 (EN)

Application

EP 82900864 A 19820201

Priority

US 23818381 A 19810225

Abstract (en)

[origin: WO8202977A1] A read-only memory array having storage cells (10-13) capable of storing more than two logic states. The size of the devices used in the storage cells (10- 13) can all be of equal size. If the devices are connected in a source follower configuration, the voltage level associated with each memory storage cell can be controlled by selectively adjusting the threshold voltage of the device. In such a memory array, it is possible for all the devices to be of equal size and therefore they can be made of a minimum size which reduces the overall size of the memory.

Abstract (fr)

Memoire morte matricielle ayant des cellules de stockage (10-13) capables de stocker plus de deux etats logiques. Les dimensions des dispositifs utilises dans les cellules de stockage (10-13) peuvent etre toutes identiques. Si les dispositifs sont connectes dans une configuration suivant la source, le niveau de tension associe a chaque cellule de stockage de la memoire peut etre commande en reglant selectivement la tension de seuil du dispositif. Dans une telle memoire matricielle, il est possible que tous les dispositifs aient la meme dimension et par consequent il est possible de les fabriquer avec une dimension minimum ce qui reduit la dimension totale de la memoire.

IPC 1-7

G11C 17/00; G11C 11/40

IPC 8 full level

G11C 11/56 (2006.01)

CPC (source: EP)

G11C 11/56 (2013.01); **G11C 11/5692** (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB NL

DOCDB simple family (publication)

WO 8202977 A1 19820902; EP 0072846 A1 19830302; IT 1186670 B 19871204; IT 8247842 A0 19820222

DOCDB simple family (application)

US 8200136 W 19820201; EP 82900864 A 19820201; IT 4784282 A 19820222